

УДК 538.915

ИЗОГНУТЫЕ ГРАФЕНОВЫЕ НАНОЛЕНТЫ И ТУННЕЛЬНЫЙ ТОК

© 2011 г. М. Б. Белоненко^{2,3}, Н. Н. Янюшкина¹, Н. Г. Лебедев¹, А. В. Жуков^{3,4}

E-mail: mbelonenko@yandex.ru

На основании уравнения Дирака в криволинейном пространстве времени, примененном для описания длинноволновых электронов в изогнутой графеновой наноленте, вычислена плотность состояний и электронный спектр. На основе полученной плотности состояний была рассчитана вольт-амперная характеристика туннельных контактов наноленты с металлом и с квантовыми точками. Обнаружена зависимость от геометрических характеристик изогнутой наноленты.

ВВЕДЕНИЕ

Начиная с открытия графена и его уникальных характеристик [1], которые позволяют рассматривать его как базу для электроники будущего, интерес исследователей в последнее время все больше и больше смещается в сторону изучения свойств графена, который модифицирован тем или иным образом (примеси, дефекты, графеновые наноленты и др.) [2]. Последнее обстоятельство связано с тем, что чистый графен не имеет энергетической щели в зонной структуре и, следовательно, создание на его основе различных структур (например, аналогов транзисторов) затруднено. Особенный интерес возникает при этом к графеновым нанолентам, которые вследствие ограниченности в пространстве в одной измерении имеют квантованный в данном направлении энергетический спектр электронов, что также может приводить к образованию энергетической щели. Кроме того, известно, что плоская структура графеновых листов неустойчива и графен имеет волнообразную искривленную поверхность. Все эти обстоятельства стимулировали в последнее время и изучение различных искривленных модификаций графена [3]. По-видимому, наиболее простой способ экспериментальной проверки изменения плотности состояний — изучение туннельного тока [4], например для контакта с металлом или квантовыми точками.

1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ И СПЕКТР ЭЛЕКТРОНОВ

Рассмотрим два вида графеновых нанолент, изогнутых вдоль либо поверхности геликоида, либо тора.

Свойства электронов в графеновой наноленте в длинноволновом приближении в окрестности

дираковской точки (например, для определенности K) будем описывать на основании обобщения уравнения Дирака для искривленного пространства времени [5]:

$$\gamma^\mu (\partial_\mu - \Omega_\mu) \Psi = 0, \quad (1)$$

здесь и далее по повторяющимся индексам, если не оговорено обратное, подразумевается суммирование. ∂_μ — частная производная по координате μ , Ω_μ — компонента спинорной связности, $\Psi = (\phi/\varphi)$ — волновая функция (вектор-столбец) состоящая из волновых функций, описывающих электроны различных подрешеток графена в окрестности дираковской точки K .

Как известно из литературы [5, 6], если задан метрический тензор, можно определить поля реперы (диады):

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta} &= e_\alpha^a e_\beta^b \eta_{ab}, \\ g^{\alpha\beta} &= e_a^\alpha e_b^\beta \eta^{ab}, \\ \eta_{ab} \eta^{bc} &= \delta_a^c, \end{aligned} \quad (2)$$

где для двумерной изогнутой поверхности $\eta_{ab} = \text{diag}(1, -1, -1)$ Тогда

$$\Omega_\mu = \frac{1}{4} \gamma_a \gamma_b e_\lambda^a g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu e_\sigma^b - \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda e_\lambda^b), \quad (3)$$

$$\Gamma_{\mu\sigma}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\nu} (g_{\sigma\nu,\mu} + g_{\nu\mu,\sigma} - g_{\mu\sigma,\nu}); \quad \gamma^\mu = e_a^\mu \gamma_a.$$

Метрика на поверхности тора и геликоида есть

$$\begin{aligned} ds^2 &= dx_0^2 - r^2 dx_1^2 - (R + r \cos x_1)^2 dx_2^2 \\ \text{и} \quad ds^2 &= dx_0^2 - dx_1^2 - (h^2 + x_1^2) dx_2^2. \end{aligned} \quad (4)$$

Равны нулю все символы Кристоффеля, кроме Γ_{12}^2 и Γ_{22}^1 ,

при этом для тора $\Omega_0 = 0$; $\Omega_1 = 0$; $\Omega_2 = \frac{1}{2} \gamma_1 \gamma_2 f'/r$ ($f = R + r \cos x_1$; $f' = \partial f / \partial x_1$),

¹ Волгоградский государственный университет.

² Волгоградский институт бизнеса.

³ Entropique Inc., London, Canada.

⁴ Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada.

для геликоида: $\Omega_0 = 0; \Omega_1 = 0; \Omega_2 = \frac{1}{2}\gamma_1\gamma_2 \times$
 $\times \frac{x_1}{(h^2 + x_1^2)^{1/2}}.$

Выбирая $\gamma_0 = \sigma_3; \gamma_1 = -i\sigma_2; \gamma_2 = -i\sigma_1$, где σ соответствующие матрицы Паули, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} V_F^{-1}\partial_t\varphi = -\frac{1}{r^2}\partial_{x_1}\Psi - \frac{i}{f^2}\partial_{x_2}\Psi + \frac{f'}{2f^2r}\Psi, \\ V_F^{-1}\partial_t\varphi = -\frac{1}{r^2}\partial_{x_1}\varphi + \frac{i}{f^2}\partial_{x_2}\varphi + \frac{f'}{2f^2r}\varphi, \end{cases} \quad (5a)$$

$$\begin{cases} V_F^{-1}\partial_t\varphi + \partial_{x_1}\Psi + \frac{i}{h^2 + x_1^2}\partial_{x_2}\Psi - \frac{x_1}{2(h^2 + x_1^2)^{3/2}}\Psi = 0, \\ -V_F^{-1}\partial_t\Psi - \partial_{x_1}\varphi + \frac{i}{h^2 + x_1^2}\partial_{x_2}\varphi - \frac{x_1}{2(h^2 + x_1^2)^{3/2}}\varphi = 0, \end{cases} \quad (5b)$$

(здесь явно введена скорость Ферми для плоского графена $\partial_0 = V_F^{-1}\partial_t$). Отметим, что, поскольку метрика (4) допускает два вектора киллинга, соответствующих трансляциям вдоль x_0, x_1 , решение (5) можно искать в виде

$$\begin{pmatrix} \varphi \\ \Psi \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \varphi(x_1) \\ \Psi(x_1) \end{pmatrix} e^{iEt - ikx_2},$$

что при переходе к уравнению на одну функцию дает окончательно:

$$\Psi'' = \left(-\frac{E^2 r^4}{V_f^2} + \frac{k_n^2 r^4}{f^4} \right) \Psi + \frac{rf'}{2f^2} \Psi' + \quad (6a)$$

$$+ \left(\frac{2k_n r^2 f'}{f^3} + \frac{rf''}{2f^2} - \frac{rf'^2}{f^3} - \frac{r^2 f'^2}{4f^4} \right) \Psi,$$

$$\Psi''' = \left(-\frac{\varepsilon^2}{V_f^2} + \frac{k^2}{(h^2 + x_1^2)^2} \right) \Psi + \quad (6b)$$

$$+ \left(-\frac{kx_1}{(h^2 + x_1^2)^{5/2}} + \frac{x_1^2}{4(h^2 + x_1^2)^3} \right) \Psi.$$

Волновой вектор k находится из граничных условий на концах наноленты.

В данном случае была выбрана нанолента типа arm-chair [3] и

$$k_n = \frac{2\pi}{3a_0} \left(\frac{2M+1+n}{2M+1} \right). \quad (7)$$

где a_0 — расстояние между атомами в углеродной решетке, M — число атомов вдоль оси наноленты, n — квантовое число. Уравнения (6) можно рассматривать как уравнение Шрёдингера с возмущением:

$$\hat{V}_{Torus} = \left[\left(\frac{2k_n r^2 f'}{f^3} + \frac{rf''}{2f^2} - \frac{rf'^2}{f^3} - \frac{r^2 f'^2}{4f^4} \right) + \frac{rf'}{2f^2} \partial_x \right],$$

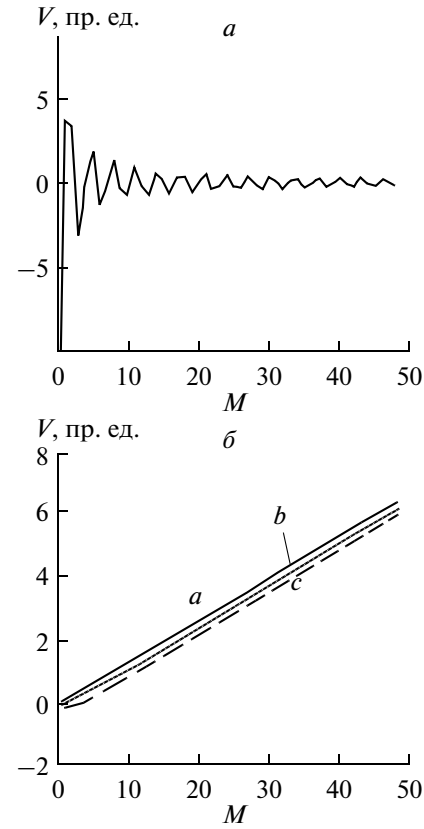


Рис. 1. Зависимость поправки к энергии V , вносимой возмущением \hat{V} от числа атомов вдоль оси наноленты M : a — для тора ($r/R = 0.1, n = 1$), b — для геликоида ($h = 2$): a) $n = 1$, b) $n = 2$, c) $n = 3$.

$$\hat{V}_{Helicoid} = \left(-\frac{kx_1}{(h^2 + x_1^2)^{5/2}} + \frac{x_1^2}{4(h^2 + x_1^2)^3} \right).$$

Спектр невозмущенной задачи в этом случае есть

$$E = \pm \sqrt{k_n^2 + k_y^2}. \quad (8)$$

Раскладывая функции, стоящие в знаменателе, в ряд Маклорена и учитывая в разложении только слагаемые не более второго порядка, вычислим первую поправку к спектру под действием возмущения \hat{V}_{Torus} и $\hat{V}_{Helicoid}$.

Зависимость возмущения от числа атомов вдоль оси наноленты M показана на рис. 1.

Зависимость, приведенная на рис. 2а, носит сложный характер, что связано с квантованием спектра электронов в графеновой наноленте согласно (6). Отметим, что аналогичный характер носит зависимость энергетической щели в углеродных нанотрубках zig-zag-типа, которая также возникает вследствие квантования спектра электронов в направлении вдоль окружности нанотрубки. Что касается рис. 2б то, как показали рас-

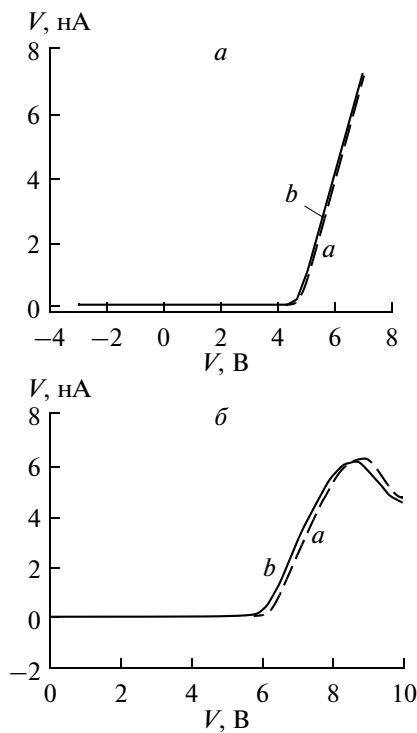


Рис. 2. Вольт-амперная характеристика контакта: изогнутая графеновая нанолента — металл: *a* — случай контакта с металлом, *b* — случай контакта с квантовыми точками. Зависимости приведены для тора (*a*); для геликоида (*b*).

четы, наиболее на поправку к энергии, на ее знак влияет величина параметризации геликоида h .

2. ТУННЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В рамках теории Кубо туннельный ток задается формулой

$$J = 4\pi e |T|^2 \times \int_{-\infty}^{\infty} dE v_A(E + eV) v_B(E) (n_f(E) - n_f(E + eV)), \quad (9)$$

$$v_A(E) = \sum_p \delta(E - E_p^A); \quad v_B(E) = \sum_q \delta(E - E_q^B),$$

где $\delta(x)$ — дельта-функция Дирака, $v_{A(B)}(E)$ — туннельная плотность состояний; $n_f(E)$ — равновесное число фермионов с энергией E . Здесь и далее

используется приближение “шероховатого” контакта: $T_{pq} = T$ (т.е. фактически накладываются ограничения на геометрию контакта, т.е. в дальнейшем рассматривается случай, когда нанолента перпендикулярна к поверхности металла). Задавшись электронным спектром графеновых нанолент с учетом поправки и выбрав в качестве вещества, с которым происходит контакт, металл либо квантовые точки с законом дисперсии

$$E_q^A = \frac{p^2}{2m} \text{ и } E_q^A = \varepsilon_0 - \Delta \cos(p), \quad (10)$$

после вычисления интегралов, входящих в (11), легко получить вольт-амперную характеристику контакта, представленную на рис. 2.

Из приведенной на рис. 2 зависимости прослеживается асимметричность поведения тока в зависимости от прикладываемого напряжения к контакту в обоих случаях. Это связано как с особенностями электронного строения (плотностью состояний) графеновых нанолент и металла, так и с процессами рекомбинации носителей в переходе, при $V > 0$ преобладающими над процессами тепловой генерации (аналогичное поведение наблюдается для кремниевых диодов). Отметим, что приведенная зависимость может иметь важное практическое применение при исследовании наноконтактов и при конструировании графеновых нанодиодов.

Также отметим, что при некоторых значениях V наблюдается участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Наличие такого участка позволяет использовать туннельный диод в качестве быстродействующего переключателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V. et al. // Science. 2004. V. 306. P. 666.
2. Zhang Y., Tan J. W., Stormer H. L., Kim P. // Nature. 2005. V. 438. P. 201.
3. Brey L., Fertig H.A. // Phys. Rev. B. 2006. V. 73. P. 235411.
4. Belonenko M.B., Lebedev N.G., Yanyushkina N.N. // J. Nanophotonics. 2010. V. 4, 041670.
5. Vozmediano M.A.H., Katsnelson M.I., Guinea F. // arXiv:1003.5179v2[cond-mat.mes-hall] 20 Jul 2010.
6. Биррелл Н., Девис П. Квантованные поля в искривленном пространстве-времени. М.: Мир, 1984. 356 с.